IGBT

**IGBT** eller Insulated-gate bipolar transistor ("bipolär transistor med isolerat styre") är en typ av transistor som är en vanlig komponent i modern kraftelektronik. Den kombinerar egenskaperna hos en MOSFET-fälteffekttransistor och en bipolär transistor och utvecklades omkring 1980 av Jayant Baliga vid General Electric.